

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日      2003年  3月28日  
Date of Application:

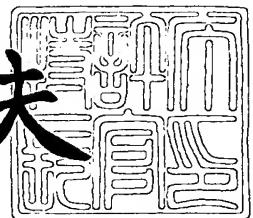
出願番号      特願2003-091476  
Application Number:  
[ST. 10/C] :      [JP2003-091476]

出願人      TDK株式会社  
Applicant(s):

2003年 9月29日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3079983

【書類名】 特許願  
【整理番号】 99P05067  
【提出日】 平成15年 3月28日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01C 7/10  
【発明の名称】 チップ状電子部品およびその製造方法  
【請求項の数】 12  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内  
【氏名】 松岡 大  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内  
【氏名】 北村 英隆  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内  
【氏名】 小笠原 正  
【特許出願人】  
【識別番号】 000003067  
【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100097180  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 前田 均

**【代理人】****【識別番号】** 100099900**【弁理士】****【氏名又は名称】** 西出 真吾**【選任した代理人】****【識別番号】** 100111419**【弁理士】****【氏名又は名称】** 大倉 宏一郎**【選任した代理人】****【識別番号】** 100117927**【弁理士】****【氏名又は名称】** 佐藤 美樹**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 043339**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 チップ状電子部品およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6 mm以下×横0.3 mm以下×厚み0.3 mm以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離（端子間ギャップ）が $50\mu\text{m}$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法（S I M S）で $\text{L}_i$ と $\text{Z}_n$ とのイオン強度比（ $\text{L}_i/\text{Z}_n$ ）を測定した場合に、 $0.001 \leq (\text{L}_i/\text{Z}_n) \leq 500$ であることを特徴とするチップ状電子部品。

【請求項 2】 前記イオン強度比が $0.01 \leq (\text{L}_i/\text{Z}_n) \leq 500$ であることを特徴とする請求項1に記載のチップ状電子部品。

【請求項 3】 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6 mm以下×横0.3 mm以下×厚み0.3 mm以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu\text{m}$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法で $\text{Na}$ と $\text{Z}_n$ とのイオン強度比（ $\text{Na}/\text{Z}_n$ ）を測定した場合に、 $0.001 \leq (\text{Na}/\text{Z}_n) \leq 100$ であることを特徴とするチップ状電子部品。

【請求項 4】 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6 mm以下×横0.3 mm以下×厚み0.3 mm以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu\text{m}$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1

としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0. 9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でKとZnとのイオン強度比（K/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (K/Zn) \leq 100$ であることを特徴とするチップ状電子部品。

【請求項5】 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0. 6 mm以下×横0. 3 mm以下×厚み0. 3 mm以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が50μm以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0. 9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でRbとZnとのイオン強度比（Rb/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (Rb/Zn) \leq 100$ であることを特徴とするチップ状電子部品。  
。

【請求項6】 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0. 6 mm以下×横0. 3 mm以下×厚み0. 3 mm以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が50μm以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0. 9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でCsとZnとのイオン強度比（Cs/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (Cs/Zn) \leq 100$ であることを特徴とするチップ状電子部品。  
。

【請求項7】 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0. 6 mm以下×横0. 3 mm以下×厚み0. 3 mm以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が50μm以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0. 9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属（A）と亜鉛（Zn）とのイオン強度比（A/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$ であることを特徴とす

るチップ状電子部品。

**【請求項 8】** 前記素子本体が、酸化亜鉛系電圧非直線性抵抗体層と内部電極層とが交互に積層された構造を有し、前記チップ状電子部品が、積層型チップバリスタである請求項 1～7 のいずれかに記載のチップ状電子部品。

**【請求項 9】** 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦 0.6 mm 以下 × 横 0.3 mm 以下 × 厚み 0.3 mm 以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が 50 μ m 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品の製造方法であって、

前記素子本体を形成する工程と、

前記素子本体の表面から素子本体の内部に向けてアルカリ金属（A）を拡散させる工程と、

その後に、前記素子本体の外面に、前記内部電極層に接続する前記一対の端子電極を形成する工程とを、有し、

前記アルカリ金属を拡散させる際に、前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を 1 としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9 × 1）までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属（A）と亜鉛（Zn）とのイオン強度比（A/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$  となる条件で、アルカリ金属を拡散させることを特徴とするチップ状電子部品の製造方法。

**【請求項 10】** 酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦 0.6 mm 以下 × 横 0.3 mm 以下 × 厚み 0.3 mm 以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が 50 μ m 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品の製造方法であって、

前記素子本体を形成する工程と、

前記素子本体の外面に、前記内部電極層に接続する端子電極を形成する工程と、

その後に、前記素子本体の表面から素子本体の内部に向けてアルカリ金属（A）を拡散させる工程と、を有し、

前記アルカリ金属を拡散させる際に、前記内部電極層の積層方向最外側から前

記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属（A）と亜鉛（Zn）とのイオン強度比（A/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$ となる条件で、アルカリ金属を拡散させることを特徴とするチップ状電子部品の製造方法。

【請求項11】 前記アルカリ金属が、Li, Na, K, Rb, Csのうちの少なくとも1つであることを特徴とする請求項9または10に記載のチップ状電子部品の製造方法。

【請求項12】 前記アルカリ金属を拡散させる際に、前記素子本体の表面に、アルカリ金属の化合物の粉体を付着させた状態で、前記素子本体を、700～1000℃の温度で熱処理し、前記素子本体の表面に対する前記粉体の付着量と、熱処理温度と、熱処理時間との内の少なくとも1つを制御することを特徴とする請求項9～11のいずれかに記載のチップ状電子部品の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

###### 【発明の属する技術分野】

本発明は、寸法が縦0.6mm×横0.3mm×厚み0.3mmよりも小型なチップ状電子部品において、ガラスコートなどの絶縁保護層が不要であり、温度変化に強く、しかも半田リフローによっても素子表面の高抵抗を維持可能であり、高信頼性で、製造が容易な積層チップバリスタなどのチップ状電子部品およびその製造方法に関する。

##### 【0002】

###### 【従来の技術】

近年、電子機器の小型化および高性能化に伴い、チップ状電子部品が必要不可欠となってきている。チップ状電子部品は、通常、回路基板上に配置され、印刷された半田とともに、熱処理され回路を形成する。この熱処理を半田リフロー処理と言う。この際、半田中には、還元力の強いフラックスが含まれており、それによってチップ部品の表面が侵されて絶縁抵抗が低下することがある。

##### 【0003】

チップ状電子部品としての積層チップバリスタも例外ではなく、半田リフローにより、積層チップバリスタの素子表面が還元され、絶縁抵抗が低下し、信頼性が劣るという不具合を生ずる。

#### 【0004】

この問題を解決するために、積層チップバリスタの素子表面にガラスをコートして、信頼性の向上を図ることが行われている（例えば、特許文献1参照）。

#### 【0005】

しかしながら、素子表面をガラスで均一にコートして覆うことは、多くの手間がかかる。また、セラミック材とガラス材の熱膨張係数が異なるため、その界面が温度サイクルなどによりダメージを受けやすい。そのため、ガラス層にクラックを生じるおそれがあり、素子を構成するセラミックの絶縁が破壊されるおそれがある。

#### 【0006】

なお、素子表面にL<sub>i</sub>またはN<sub>a</sub>を拡散させ、素子表面を高抵抗化する方法が提案されている（特許文献2参照）。この特許文献に記載された発明では、素子表面のL<sub>i</sub>またはN<sub>a</sub>のSIMSイオン強度M<sub>1</sub>と、表面から10μmの深さ部分でのL<sub>i</sub>またはN<sub>a</sub>のSIMSイオン強度M<sub>2</sub>との比（M<sub>1</sub>/M<sub>2</sub>）を、10≤（M<sub>1</sub>/M<sub>2</sub>）<50000としている。

#### 【0007】

しかしながら、この方法では、電気メッキ時の外観不良を改善することはできても、半田リフローにおけるフラックスからの還元に対しては不十分であることが判明した。すなわち、半田リフロー時に活性化されたフラックスの還元力は、電気メッキの還元力よりも非常に大きいため、L<sub>i</sub>またはN<sub>a</sub>が拡散している範囲の厚みが10μm程度では、半田リフローに対しては不十分であった。

#### 【0008】

なお、近時、電子機器のさらなる小型化が求められており、たとえば、その寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）と極小サイズのチップ状電子部品の開発も進んできている。

【特許文献1】特開平6-96907号公報

**【特許文献 2】特開平 9-246017 号公報****【0009】****【発明が解決しようとする課題】**

本発明の目的は、極小サイズ（たとえば、その寸法が縦 0.6 mm 以下 × 横 0.3 mm 以下 × 厚み 0.3 mm 以下）のチップ状電子部品において、ガラスコートなどの絶縁保護層が不要であり、温度変化に強く、しかも半田リフローによつても素子表面の高抵抗を維持可能であり、高信頼性で、製造が容易な積層チップバリスタなどのチップ状電子部品およびその製造方法を提供することである。

**【0010】****【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するために、本発明の第 1 の観点に係るチップ状電子部品は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦 0.6 mm 以下 × 横 0.3 mm 以下 × 厚み 0.3 mm 以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離（端子間ギャップ）が  $50 \mu\text{m}$  以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であつて、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を 1 としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9 × 1）までの範囲を二次イオン質量分析法（SIMS）で  $\text{Li}$  と  $\text{Zn}$  とのイオン強度比 ( $\text{Li}/\text{Zn}$ ) を測定した場合に、 $0.001 \leq (\text{Li}/\text{Zn}) \leq 500$  であることを特徴とする。

**【0011】**

好ましくは、前記イオン強度比が  $0.01 \leq (\text{Li}/\text{Zn}) \leq 500$  である。

**【0012】**

本発明の第 2 の観点に係るチップ状電子部品は、

酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦 0.6 mm 以下 × 横 0.3 mm 以下 × 厚み 0.3 mm 以下）の素子本体と、

該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が  $50 \mu\text{m}$  以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であつて、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を 1

としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でNaとZnとのイオン強度比（Na/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (Na/Zn) \leq 100$ であることを特徴とする。

#### 【0013】

本発明の第3の観点に係るチップ状電子部品は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体と、該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu m$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でKとZnとのイオン強度比（K/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (K/Zn) \leq 100$ であることを特徴とする。

#### 【0014】

本発明の第4の観点に係るチップ状電子部品は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体と、該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu m$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でRbとZnとのイオン強度比（Rb/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (Rb/Zn) \leq 100$ であることを特徴とする。

#### 【0015】

本発明の第5の観点に係るチップ状電子部品は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体と、該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu m$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でCsとZnとのイオン強度比（Cs/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (Cs/Zn) \leq 100$ であることを特徴とする。

#### 【0016】

本発明の第6の観点に係るチップ状電子部品は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体と、該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu m$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品であって、

前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属（A）と亜鉛（Zn）とのイオン強度比（A/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$ であることを特徴とする。

#### 【0017】

本発明の第1の観点に係るチップ状電子部品の製造方法は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体と、該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu m$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品の製造方法であって、

前記素子本体を形成する工程と、前記素子本体の表面から素子本体の内部に向けてアルカリ金属（A）を拡散させる工程と、その後に、前記素子本体の外面に、前記内部電極層に接続する前記一対の端子電極を形成する工程とを、有し、前記アルカリ金属を拡散させる際に、前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属（A）と亜鉛

(Zn) とのイオン強度比 (A/Zn) を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$  となる条件で、アルカリ金属を拡散させることを特徴とする。

### 【0018】

本発明の第2の観点に係るチップ状電子部品の製造方法は、酸化亜鉛系材料層と内部電極層とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体と、該素子本体の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離が $50\mu m$ 以上の一対の端子電極とを、持つチップ状電子部品の製造方法であって、前記素子本体を形成する工程と、前記素子本体の外面に、前記内部電極層に接続する端子電極を形成する工程と、その後に、前記素子本体の表面から素子本体の内部に向けてアルカリ金属 (A) を拡散させる工程と、を有し、前記アルカリ金属を拡散させる際に、前記内部電極層の積層方向最外側から前記素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ (0.9×1) までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属 (A) と亜鉛 (Zn) とのイオン強度比 (A/Zn) を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$  となる条件で、アルカリ金属を拡散させることを特徴とする。

### 【0019】

好ましくは、前記アルカリ金属が、Li, Na, K, Rb, Cs のうちの少なくとも1つである。

### 【0020】

好ましくは、前記アルカリ金属を拡散させる際に、前記素子本体の表面に、アルカリ金属の化合物の粉体を付着させた状態で、前記素子本体を、 $700 \sim 1000^{\circ}\text{C}$  の温度で熱処理し、前記素子本体の表面に対する前記粉体の付着量と、熱処理温度と、熱処理時間との内の少なくとも1つを制御する。

### 【0021】

本発明において、チップ状電子部品としては、特に限定されないが、好ましくは、前記素子本体が、酸化亜鉛系電圧非直線性抵抗体層と内部電極層とが交互に

積層された構造を有し、前記チップ状電子部品が、積層型チップバリスタである

。

### 【0022】

#### 【発明の作用】

本件出願人は、先に、Li、Na、K、Rb、Csのアルカリ金属を、単体および複数で、チップバリスタ素体表面を含む深さ $100\mu m$ の範囲に、より多く含ませる技術を提案した（特願2002-313722号）。たとえば、Liの場合、二次イオン質量分析法（SIMS）によるLiとZnについてイオン強度比を測定したとき、イオン強度測定結果が、LiとZnのイオン強度比（Li/Zn）で、 $0.001 \leq (Li/Zn) \leq 500$ である積層型チップバリスタを構成することにより、半田リフロー時の活性化されたフラックスにおいても安定なチップバリスタが得られる、というものである。

### 【0023】

しかしながら、この技術を、たとえば、その寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）と極小サイズのチップにそのまま適用した場合には、次に示す不都合を生じることが判明した。一般に、積層チップバリスタは、その素子本体中の積層方向に隣り合う2つの内部電極層の間でバリスタ特性を発現させる。上記極小サイズのチップの場合、内部電極層のうち積層方向最外側に配置される内部電極層と、素子本体の表面との距離が $100\mu m$ 未満となることがある。この場合に、先に提案したような、チップバリスタ素体表面を含む深さ $100\mu m$ の範囲まで絶縁層を形成すると、内部電極層の積層方向最外側よりも内側のチップ内部（バリスタ特性を発現する内部電極層間）にまで、上記アルカリ金属が拡散することがあり、この影響によって電気特性が変動することもありうる。

### 【0024】

本発明者らは、積層チップバリスタなどのチップ状電子部品において、その素子本体中の内部電極層の積層方向最外側から該素子本体の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体の表面から深さ（ $0.9 \times 1$ ）までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属（A）と亜鉛（Zn）とのイオン強度比（A/

$Z_n$ ）を測定した場合に、所定範囲のイオン強度比とすることにより、極小サイズ（たとえば、その寸法が縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）においても、半田リフローにおけるフラックスによる絶縁抵抗値の低下を防止でき、半田リフロー後の絶縁不良率を大幅に低減できることを見出した。

#### 【0025】

アルカリ金属が拡散している素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲の状態は、必ずしも明らかではないが、素子本体の外側に位置する酸化亜鉛系材料層に含まれる酸化亜鉛粒子中に、アルカリ金属が固溶していると考えられる。

#### 【0026】

本発明では、前記のイオン強度比を所定範囲にすることで、この素子本体の表面から深さ（0.9×1）までの範囲は、他の部分に比べて、高抵抗層となり、半田リフローによるフラックスの還元作用から素子表面を電流がリークするのを防止する。そのため、半田リフロー後の絶縁抵抗値の低下を防止できると共に、絶縁不良率を低下させることが可能になる。また、ガラスコートのような熱膨張係数の異なる物質を用いないので、ヒートサイクルに強い。また、ガラスコートなどの絶縁化手法によらずとも（極小サイズのチップ状電子部品において、ガラスコートは適用が困難であるばかりか、仮に適用してみても、チップがガラスによってだるま状となり、チップのマウント時に悪影響がでる）、端子間ギャップ（図1の符号5に相当）のより狭い極小サイズのチップで、端子間の絶縁を確実に確保することができる。このため、電子部品の高信頼性を維持することができる。

#### 【0027】

また、本発明では、アルカリ金属供給源を素子本体の表面に付着させ、熱処理にてアルカリ金属を素子本体の表面から内部に向けて拡散させることにより高抵抗層を形成し、従来と異なり、絶縁ガラス層をコーティングする必要が無いため、複雑な設備や工程が不要であり、容易且つ安価に高信頼性のチップ状電子部品を製造することができる。

#### 【0028】

### 【発明の実施の形態】

以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。ここにおいて、  
図1は本発明の一実施形態に係る積層チップバリスタの概略断面図、  
図2は本発明の一実施形態に係る積層チップバリスタの製造工程を示すフロー  
チャート図、  
図3は本発明の他の実施形態に係る積層チップバリスタの製造工程を示すフロー  
チャート図である。

#### 【0029】

##### 積層チップバリスタ

図1に示すように、チップ状電子部品の一例としての積層チップバリスタ10は、電圧非直線性抵抗体層1と内部電極層2とが交互に積層された構造の素子本体12を有する。素子本体12の外面には、一対の外部端子電極3が形成してある。一対の外部端子電極3は、同一平面上で対向する端部同士の距離（端子間ギャップ。図1において符号5に相当）が50μm以上である。内部電極層2は、素子本体12の対向する両端面から交互に露出しており、それぞれの外部端子電極3に接続してあり、バリスタ回路を形成している。

#### 【0030】

内部電極層2の積層方向外側には、最外層1aが積層され、内部電極層2が保護されている。最外層1aは、通常、抵抗体層1と同じ材質で構成される。抵抗体層1の材質については後述する。また、素子本体12の周囲に形成してある高抵抗体層4についても後述する。

#### 【0031】

素子本体12の形状は、特に制限はなく、通常、直方体状とされる。本発明では、素子本体12の寸法が、縦（0.6mm以下、好ましくは0.4mm以下）×横（0.3mm以下、好ましくは0.2mm以下）×厚み（0.3mm以下、好ましくは0.2mm以下）の極小サイズを対象としている。

この極小サイズゆえに、本発明では、最外層1aの厚みは、通常100μm未満、好ましくは90μm以下とされる。なお、一対の内部電極層2に挟まれる抵抗体層1の層間厚みによっては、最外層1aの厚みが100μmを超えることも

ある。

### 【0032】

#### 電圧非直線性抵抗体層1

電圧非直線性抵抗体層1（最外層1aも同様）は、酸化亜鉛系バリスタ材料層で構成される。この酸化亜鉛系バリスタ材料層は、例えばZnOを主成分とし、副成分として希土類元素、Co、IIIb族元素（B、Al、GaおよびIn）、Si、Cr、アルカリ金属元素（K、RbおよびCs）およびアルカリ土類金属元素（Mg、Ca、SrおよびBa）等を含む材料で構成される。または、ZnOを主成分とし、副成分としてBi、Co、Mn、Sb、Al等を含む材料で構成されても良い。

### 【0033】

ZnOを含む主成分は、電圧一電流特性における優れた電圧非直線性と、大きなサージ耐量とを発現する物質として作用する。なお、電圧非直線性とは、端子電極3の間に徐々に増大する電圧を印加する際に、素子に流れる電流が非直線的に増大する現象を言う。

### 【0034】

抵抗体層1における主成分としてのZnOの含有量は、特に限定されないが、通常、抵抗体層1を構成する全体の材料を100質量%とした場合に、通常、99.8～69.0質量%である。

### 【0035】

#### 内部電極層2

内部電極層2に含有される導電材は、特に限定されないが、PdまたはAg-Pd合金からなることが好ましい。内部電極層2の厚さは、用途に応じて適宜決定すればよいが、通常0.5～5μm程度である。

### 【0036】

#### 外部端子電極3

外部端子電極3に含有される導電材は、特に限定されないが、通常、AgやAg-Pd合金などを用いる。さらに、必要に応じ、AgやAg-Pd合金などの下地層の表面に、電気メッキ等により、NiおよびSn/Pb膜を形成する。外

部端子電極3の厚さは、用途に応じて適宜決定すればよいが、通常10～50μm程度である。

### 【0037】

#### 高抵抗層4

高抵抗層4は、素子本体12の外表面全体を覆うように形成してある。この高抵抗層4は、熱分解して酸化物となるアルカリ金属化合物を素子本体12の表面に付着させた状態で熱処理することにより、素子本体12の表面から内部に向けてアルカリ金属を拡散させることにより形成される。

### 【0038】

なお、高抵抗層4と素子本体12の最外層1aとの境界は、必ずしも明確ではなく、最外層1aに対してアルカリ金属が拡散した範囲が高抵抗層4となる。この高抵抗層4は、電圧非直線性抵抗体層1を半田リフロー時に保護する役割を有する。

### 【0039】

この高抵抗層4の厚みは、特に限定されないが、少なくとも10μm以上であり、内部電極層2までは到達しない厚みである。この厚みが薄すぎると、本発明の効果が少なく、厚すぎると、電圧非直線性抵抗体層1の電気特性に悪影響を及ぼす場合がある。

### 【0040】

この高抵抗層4では、前記内部電極層2の積層方向最外側から前記素子本体12の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体12の表面から深さ(0.9×1)までの範囲を二次イオン質量分析法でアルカリ金属(A)と亜鉛(Zn)とのイオン強度比(A/Zn)を測定した場合に、 $0.001 \leq (A/Zn) \leq 500$ となる。

### 【0041】

なお、イオン強度比は、二次イオン質量分析法(SIMS)により、求めることができる。SIMSは、表面層からミクロンオーダで、深さ方向のイオン濃度分布を高感度で測定できる方法である。高エネルギー(数keV～20keV)のイオンビームを固体表面に照射すると、スパッタ現象により試料構成原子が中

性子またはイオンとして放出される。このようにして、二次的に放出されるイオンを質量分析計で、質量・電荷の比に分けて、試料表面の元素分析および化合物分析を行う方法がS I M Sである。

#### 【0042】

高抵抗層4中に拡散されるアルカリ金属としては、特に限定されないが、好ましくはLi, Na, K, Rb, Csのうちの少なくとも1つ、さらに好ましくはLiである。

#### 【0043】

アルカリ金属がLiである場合には、LiとZnとのイオン強度比(Li/Zn)は、好ましくは $0.001 \leq (Li/Zn) \leq 500$ 、さらに好ましくは $0.01 \leq (Li/Zn) \leq 500$ である。

#### 【0044】

アルカリ金属がNaである場合には、NaとZnとのイオン強度比(Na/Zn)は、好ましくは $0.001 \leq (Na/Zn) \leq 100$ 、さらに好ましくは $0.01 \leq (Na/Zn) \leq 100$ である。

#### 【0045】

アルカリ金属がKである場合には、KとZnとのイオン強度比(K/Zn)は、好ましくは $0.001 \leq (K/Zn) \leq 100$ 、さらに好ましくは $0.01 \leq (K/Zn) \leq 100$ である。

#### 【0046】

アルカリ金属がRbである場合には、RbとZnとのイオン強度比(Rb/Zn)は、好ましくは $0.001 \leq (Rb/Zn) \leq 100$ 、さらに好ましくは $0.01 \leq (Rb/Zn) \leq 100$ である。

#### 【0047】

アルカリ金属がCsである場合には、CsとZnとのイオン強度比(Cs/Zn)は、好ましくは $0.001 \leq (Cs/Zn) \leq 100$ 、さらに好ましくは $0.1 \leq (Cs/Zn) \leq 100$ である。

#### 【0048】

イオン強度比が小さすぎる場合には、半田リフロー後の絶縁抵抗値が、低すぎ

る傾向にあり、イオン強度比が大きすぎると、電圧非直線性抵抗体層1の電気特性に悪影響を及ぼすおそれがあると共に、半田リフロー後の絶縁抵抗値の増大が低下する傾向にある。

#### 【0049】

##### 積層チップバリスタ10の製造方法

次に、図2に基づいて、本発明に係る積層チップバリスタ10の製造工程を説明する。

#### 【0050】

まず、印刷工法またはシート工法等により、内部電極層2が1層おきに互い違いに両端部に露出するように、電圧非直線性抵抗体層1（バリスタ層）と内部電極層2を交互に積層し、その積層方向の両端に最外層1aを積層し、積層体を形成する（図2の工程a）。

#### 【0051】

次に、この積層体を切断し、グリーンチップを得る（工程b）。

#### 【0052】

次に、必要に応じて脱バインダー処理を行い、グリーンチップを焼成し、チップ本体12となるチップ素体を得る（工程c）。

#### 【0053】

得られたチップ素体を密閉回転ポットにより、チップ素体の表面にアルカリ金属化合物を付着させる（工程d）。アルカリ金属化合物としては、特に限定されないが、熱処理することにより、アルカリ金属が素子本体12の表面から内部に拡散できる化合物であり、アルカリ金属の酸化物、水酸化物、塩化物、硝酸塩、硼酸塩、炭酸塩および亜硫酸塩等が用いられる。アルカリ金属化合物の付着量を制御することにより、前記のイオン強度比を制御することができる。

#### 【0054】

次に、このアルカリ金属化合物が付着しているチップ素体を電気炉で、所定の温度、および時間で熱処理する（工程e）。その結果、アルカリ金属化合物からアルカリ金属がチップ素体の表面から内部に向けて拡散し、高抵抗層4が形成された素子本体12が得られる。このときの熱処理温度および熱処理時間により

、前記のイオン強度比を制御することができると共に、高抵抗層4の厚みを制御することができる。好ましい熱処理温度は、700～1000℃であり、熱処理雰囲気は大気中である。また、熱処理時間は、好ましくは10分～4時間である。

#### 【0055】

次に、熱処理後の素体の両端部に端子電極を塗布、焼き付けしてA g下地電極を形成する（工程f）。ここでは、下地電極材として、A gを選択しているが、素子本体12に対する焼き付きが良く、内部電極層2を構成する材質との接続性が良く、また、後続のメッキ工程でメッキが付き易い材料であれば、いずれの材料も使用できる。

#### 【0056】

最後に、下地電極の表面に電気メッキにより、Niメッキ膜および／またはSn／Pbメッキ膜を形成し（工程g）、積層チップバリスタ10を得る。

#### 【0057】

なお、アルカリ金属を素子本体12の表面から拡散させるための手段としては、上記の手段に限らず、たとえば以下の手段を採用することができる。すなわち、端子電極3を形成する前の素子本体12をアルカリ供給源中に埋めて熱処理する方法、スプレーなどで溶液化したアルカリ供給源を素子本体12の外周に均一に振りかけた後に熱処理する方法、アルカリ金属供給源粉が混じるエアを素子本体12の外周に均一に振りかけた後に熱処理する方法などが例示される。

#### 【0058】

これらの方法では、素子本体12の両端部に露出している内部電極層2の露出端面に対してもアルカリ金属が多少拡散することになるが、内部電極層2の導電性に影響を与えることはない。

#### 【0059】

なお、内部電極層2の露出端面に対するアルカリ金属の拡散を確実に防止するには、たとえば図3に示すように、高抵抗層の形成（工程dおよびe）を、端子電極形成（工程f）の後に行っても良い。その場合には、図1に示す高抵抗層4は、端子電極3の内側には形成されない。したがって、アルカリ金属が内部電極

層 2 の露出端面から拡散することもない。また、端子電極を塗布乾燥後、アルカリ金属を表面に付着させ、焼付を行うと、焼付とともに、アルカリ金属の素体への拡散も同時にに行え、工程の簡略化ができる。

#### 【0060】

なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々に改変することができる。

#### 【0061】

##### 【実施例】

以下、本発明を、さらに詳細な実施例に基づき説明するが、本発明は、これらの実施例に限定されない。

#### 【0062】

##### 実施例1

図2に示す工程a～cおよび通常方法に従い、0603形状（外形寸法：0.6 mm×0.3 mm×0.3 mm）の素子本体12となるチップ素体を形成した。なお、チップ素体の非直線性抵抗層1および最外層1aは、酸化亜鉛系材料で構成しており、具体的には、純度99.9%のZnO（99.725モル%）に、Prを0.5モル%、Coを1.5モル%、Alを0.005モル%、Kを0.05モル%、Crを0.1モル%、Caを0.1モル%、Siを0.02モル%の割合で添加したもので構成した。また、内部電極層2は、Pdで構成した。

#### 【0063】

得られたチップ素体を、密閉回転ポットにより、チップ素体表面にLi<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>の粉末を付着させた。Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>の粉末の平均粒径は、3 μmであった。

#### 【0064】

なお、Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>の投入量は、チップ素体1個当たり、0.01 μg～10 mgの範囲とした。この投入量の増減により、後述するイオン強度比が異なる試料が得られることになる。

#### 【0065】

$\text{Li}_2\text{CO}_3$  の粉末が付着したチップ素体を、 $700 \sim 1000^\circ\text{C}$ の熱処理温度で、10分～4時間、空气中で熱処理し、チップ素体の表面から $\text{Li}$ を拡散させ、その表面近傍に高抵抗層4を形成した。これらの熱処理温度および熱処理時間を変化させることで、後述するイオン強度比が異なる試料が得られることになる。

#### 【0066】

その後は、通常の方法で、 $\text{Ag}$ 下地電極を形成し、下地電極の表面に電気メッキにより、 $\text{Ni}$ メッキ膜および $\text{Sn}/\text{Pb}$ メッキ膜を形成して端子電極3を形成し、積層チップバリスタ10を得た。なお、端子間ギャップ5については、5種類の異なる態様で作製した( $20\ \mu\text{m}, 50\ \mu\text{m}, 100\ \mu\text{m}, 300\ \mu\text{m}, 500\ \mu\text{m}$ )。

#### 【0067】

このようにして得られた複数の積層チップバリスタ試料について、素子本体の表面から深さ( $0.9 \times 1$ )までの範囲を二次イオン質量分析法で $\text{Li}$ と $\text{Zn}$ とのイオン強度比( $\text{Li}/\text{Zn}$ )を測定した。また、半田リフロー前後の絶縁抵抗値を測定し、絶縁不良率を求め、表1にまとめた。

#### 【0068】

なお、半田リフローは、基板にブラックス入りのクリーム半田を印刷し、素子をマウントした後、ピーク温度が $230^\circ\text{C}$ であるリフロー炉を通すことにより行った。

#### 【0069】

$\text{Li}/\text{Zn}$ のイオン強度比は、二次イオン質量分析法(SIMS)により、内部電極層2の積層方向最外側から前記素子本体12の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体12の表面から深さ( $0.9 \times 1$ )までの値を平均して求めた。また、絶縁抵抗値は、印加電圧3Vで測定し、100個の平均値から求め、絶縁不良率は、 $1\text{M}\Omega$ に満たない素子を不良として計算した。なお、半田リフロー前の素子は、いずれも、絶縁抵抗は $100\text{M}\Omega$ 以上であった。

【表 1】

試料番号	端子間 ギャップ $\mu\text{m}$	イオン強度比 (Li/Zn)	半田リフロー後	
			絶縁抵抗値 $M\Omega$	不良率 %
*1	20	—(未処理)	0.02	100
*2		0.0001	0.1	100
*3		0.001	0.12	100
*4		0.01	0.1	100
*5		0.1	0.13	100
*6		1	0.09	100
*7		10	0.36	98
*8		100	0.26	100
*9		500	0.07	100
*10		1000	—	サンプル作製できず
*11	50	—(未処理)	0.09	100
*12		0.0001	0.53	90
13		0.001	3.8	0
14		0.01	11	0
15		0.1	21	0
16		1	44	0
17		10	100	0
18		100	31	0
19		500	16	0
*20		1000	—	サンプル作製できず
*21	100	—(未処理)	0.11	100
*22		0.0001	0.77	87
23		0.001	4.3	0
24		0.01	27	0
25		0.1	67	0
26		1	120	0
27		10	210	0
28		100	110	0
29		500	38	0
*30		1000	—	サンプル作製できず
*31	300	—(未処理)	0.1	100
*32		0.0001	0.81	82
33		0.001	4.2	0
34		0.01	15	0
35		0.1	58	0
36		1	160	0
37		10	250	0
38		100	180	0
39		500	53	0
*40		1000	—	サンプル作製できず
*41	500	—(未処理)	0.12	100
*42		0.0001	0.9	65
43		0.001	4.5	0
44		0.01	21	0
45		0.1	55	0
46		1	98	0
47		10	260	0
48		100	210	0
49		500	78	0
*50		1000	—	サンプル作製できず

試料番号の\*は本発明の範囲外である。

### 【0070】

表1に示すように、Li未処理の素子は、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が1MΩ未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%以上と高かった（試料1, 11, 21, 31, 41）。

### 【0071】

端子間ギャップが20μmの素子は、Li処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が1MΩ未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も98%以上と高かった（試料2～9）。絶縁不良率の改善に至らなかったのは、ギャップ間の高抵抗化に寄与しているZnO結晶粒界の数が数個しか存在しないため、抵抗が低下する経路が発生する確率が増大したためと考えられる。

### 【0072】

イオン強度比が0.0001以下の素子は、Li処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が1MΩ未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も65%以上と高かった（試料12, 22, 32, 42）。

### 【0073】

端子間ギャップが50μm以上で、かつイオン強度比が0.001以上、500以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が3.8MΩ以上で、1MΩ未満を示す素子は一つもなく、しかも不良率は全て0であった（試料13～19, 23～29, 33～39, 43～49）。特に、0.01以上500以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が10MΩ以上で、より好ましいことが確認できた。

本実施例では、Li拡散による高抵抗化の影響がバリスタ試料の電気特性に影響を与えないことが確認できた。これにより、高信頼性を確保できる。

### 【0074】

なお、イオン強度比が1000以上のサンプルは、作製できなかった（試料10, 20, 30, 40, 50）。また、試料番号2～9, 12～19, 22～29, 32～39, 42～49については、Li拡散処理の前後において、バリスタ特性（電圧非直線性）は変化しないことが、別の実験により確認された。

### 【0075】

#### 実施例2

$\text{Li}_2\text{CO}_3$  の代わりに、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$  を用いる以外は、実施例1と同様の条件で、素子を作製した。この結果を表2にまとめた。

【表2】

試料番号	端子間 ギャップ $\mu\text{m}$	イオン強度比 (Na/Zn)	半田リフロー後	
			絶縁抵抗値 $M\Omega$	不良率 %
*51	20	-(未処理)	0.02	100
*52		0.0001	0.1	100
*53		0.001	0.09	100
*54		0.01	0.12	100
*55		0.1	0.11	100
*56		1	0.15	100
*57		10	0.21	100
*58		100	0.2	100
*59		500	-	サンプル作製できず
*60		1000	-	サンプル作製できず
*61	50	-(未処理)	0.09	100
*62		0.0001	0.29	100
63		0.001	3.3	4
64		0.01	9	0
65		0.1	18	0
66		1	36	0
67		10	75	0
68		100	33	0
*69		500	-	サンプル作製できず
*70		1000	-	サンプル作製できず
*71	100	-(未処理)	0.11	100
*72		0.0001	0.36	100
73		0.001	5.1	0
74		0.01	13	0
75		0.1	29	0
76		1	45	0
77		10	170	0
78		100	74	0
*79		500	-	サンプル作製できず
*80		1000	-	サンプル作製できず
*81	300	-(未処理)	0.1	100
*82		0.0001	0.38	100
83		0.001	5	0
84		0.01	12	0
85		0.1	29	0
86		1	56	0
87		10	190	0
88		100	70	0
*89		500	-	サンプル作製できず
*90		1000	-	サンプル作製できず
*91	500	-(未処理)	0.12	100
*92		0.0001	0.26	100
93		0.001	5.2	0
94		0.01	16	0
95		0.1	31	0
96		1	46	0
97		10	160	0
98		100	72	0
*99		500	-	サンプル作製できず
*100		1000	-	サンプル作製できず

試料番号の\*は本発明の範囲外である。

**【0076】**

表2に示すように、Na未処理の素子は、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%以上と高かった（試料51, 61, 71, 81, 91）。

**【0077】**

端子間ギャップが $20\text{ }\mu\text{m}$ の素子は、Na処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料52～58）。絶縁不良率の改善に至らなかったのは、上記実施例1と同様の理由と考えられる。

**【0078】**

イオン強度比が0.0001以下の素子は、Na処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料62, 72, 82, 92）。

**【0079】**

端子間ギャップが $50\text{ }\mu\text{m}$ 以上で、かつイオン強度比が0.001以上、10以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が $3.3\text{ M}\Omega$ 以上で、 $1\text{ M}\Omega$ 未満を示す素子は一つもなく、しかも不良率は4%以下であった（試料63～68, 73～78, 83～88, 93～98）。特に、0.01以上100以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が $10\text{ M}\Omega$ 以上で、より好ましいことが確認できた。

本実施例では、Na拡散による高抵抗化の影響がバリスタ試料の電気特性に影響を与えないことが確認できた。これにより、高信頼性を確保できる。

**【0080】**

なお、イオン強度比が500以上のサンプルは、作製できなかった（試料59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99, 100）。また、試料番号52～58, 62～68, 72～78, 82～88, 92～98については、Na拡散処理の前後において、バリスタ特性（電圧非直線性）は変化しないことが、別の実験により確認された。

**【0081】**実施例3

$\text{Li}_2\text{CO}_3$  の代わりに、 $\text{K}_2\text{CO}_3$  を用いる以外は、実施例 1 と同様の条件で、素子を作製した。この結果を表 3 にまとめた。

【表3】

試料番号	端子間 ギャップ $\mu\text{m}$	イオン強度比 (K/Zn)	半田リフロー後	
			絶縁抵抗値 $M\Omega$	不良率 %
*101	20	-(未処理)	0.02	100
*102		0.0001	0.08	100
*103		0.001	0.13	100
*104		0.01	0.2	100
*105		0.1	0.14	100
*106		1	0.13	100
*107		10	0.16	100
*108		100	0.018	100
*109		500	-	サンプル作製できず
*110		1000	-	サンプル作製できず
*111	50	-(未処理)	0.09	100
*112		0.0001	0.11	100
113		0.001	4.1	2
114		0.01	8.5	0
115		0.1	12	0
116		1	26	0
117		10	49	0
118		100	36	0
*119		500	-	サンプル作製できず
*120		1000	-	サンプル作製できず
*121	100	-(未処理)	0.11	100
*122		0.0001	0.2	100
123		0.001	5.6	0
124		0.01	11	0
125		0.1	23	0
126		1	33	0
127		10	62	0
128		100	40	0
*129		500	-	サンプル作製できず
*130		1000	-	サンプル作製できず
*131	300	-(未処理)	0.1	100
*132		0.0001	0.26	100
133		0.001	6.5	0
134		0.01	12	0
135		0.1	21	0
136		1	31	0
137		10	59	0
138		100	40	0
*139		500	-	サンプル作製できず
*140		1000	-	サンプル作製できず
*141	500	-(未処理)	0.12	100
*142		0.0001	0.25	100
143		0.001	6.8	0
144		0.01	15	0
145		0.1	26	0
146		1	35	0
147		10	61	0
148		100	45	0
*149		500	-	サンプル作製できず
*150		1000	-	サンプル作製できず

試料番号の\*は本発明の範囲外である。

**【0082】**

表3に示すように、K未処理の素子は、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%以上と高かった（試料101, 111, 121, 131, 141）。

**【0083】**

端子間ギャップが $20\mu\text{m}$ の素子は、K処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料102～108）。絶縁不良率の改善に至らなかったのは、上記実施例1と同様の理由と考えられる。

**【0084】**

イオン強度比が0.0001以下の素子は、K処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料112, 122, 132, 142）。

**【0085】**

端子間ギャップが $50\mu\text{m}$ 以上で、かつイオン強度比が0.001以上、1.0以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が $4.1\text{ M}\Omega$ 以上で、 $1\text{ M}\Omega$ 未満を示す素子は一つもなく、しかも不良率は2%以下であった（試料113～118, 123～128, 133～138, 143～148）。特に、0.01以上1.00以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が $8.5\text{ M}\Omega$ 以上で、より好ましいことが確認できた。

本実施例では、K拡散による高抵抗化の影響がバリスタ試料の電気特性に影響を与えないことが確認できた。これにより、高信頼性を確保できる。

**【0086】**

なお、イオン強度比が500以上のサンプルは、作製できなかった（試料109, 110, 119, 120, 129, 130, 139, 140, 149, 150）。また、試料番号102～108, 112～118, 122～128, 132～138, 142～148については、K拡散処理の前後において、バリスタ特性（電圧非直線性）は変化しないことが、別の実験により確認された。

**【0087】**

実施例4

$\text{Li}_2\text{CO}_3$  の代わりに、 $\text{Rb}_2\text{CO}_3$  を用いる以外は、実施例1と同様の条件で、素子を作製した。この結果を表4にまとめた。

【表4】

試料番号	端子間 ギャップ $\mu\text{m}$	イオン強度比 (Rb/Zn)	半田リフロー後	
			絶縁抵抗値 $M\Omega$	不良率 %
*151	20	-(未処理)	0.02	100
*152		0.0001	0.06	100
*153		0.001	0.09	100
*154		0.01	0.1	100
*155		0.1	0.11	100
*156		1	0.1	100
*157		10	0.14	100
*158		100	0.15	100
*159		500	-	サンプル作製できず
*160		1000	-	サンプル作製できず
*161	50	-(未処理)	0.09	100
*162		0.0001	0.1	100
163		0.001	0.8	85
164		0.01	4.5	3
165		0.1	10	0
166		1	23	0
167		10	42	0
168		100	37	0
*169		500	-	サンプル作製できず
*170		1000	-	サンプル作製できず
*171	100	-(未処理)	0.11	100
*172		0.0001	0.2	100
173		0.001	1.1	38
174		0.01	6.9	0
175		0.1	17	0
176		1	26	0
177		10	52	0
178		100	40	0
*179		500	-	サンプル作製できず
*180		1000	-	サンプル作製できず
*181	300	-(未処理)	0.1	100
*182		0.0001	0.21	100
183		0.001	1.2	26
184		0.01	8.3	0
185		0.1	22	0
186		1	35	0
187		10	49	0
188		100	46	0
*189		500	-	サンプル作製できず
*190		1000	-	サンプル作製できず
*191	500	-(未処理)	0.12	100
*192		0.0001	0.26	100
193		0.001	1.2	22
194		0.01	8.1	0
195		0.1	23	0
196		1	36	0
197		10	50	0
198		100	50	0
*199		500	-	サンプル作製できず
*200		1000	-	サンプル作製できず

試料番号の\*は本発明の範囲外である。

### 【0088】

表4に示すように、Rb未処理の素子は、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%以上と高かった（試料151, 161, 171, 181, 191）。

### 【0089】

端子間ギャップが $20\text{ }\mu\text{m}$ の素子は、Rb処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料152～158）。絶縁不良率の改善に至らなかったのは、上記実施例1と同様の理由と考えられる。

### 【0090】

イオン強度比が0.0001以下の素子は、Rb処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が $1\text{ M}\Omega$ 未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料162, 172, 182, 192）。

### 【0091】

端子間ギャップが $50\text{ }\mu\text{m}$ 以上で、かつイオン強度比が0.001以上、1.0以下の素子は、試料163を除き、絶縁抵抗値の平均が $1.1\text{ M}\Omega$ 以上で、 $1\text{ M}\Omega$ 未満を示す素子はなく、しかも不良率は38%以下であった（試料164～168, 173～178, 183～188, 193～198）。特に、0.01以上1.0以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が $4.5\text{ M}\Omega$ 以上で、より好ましいことが確認できた。

本実施例では、Rb拡散による高抵抗化の影響がバリスタ試料の電気特性に影響を与えないことが確認できた。これにより、高信頼性を確保できる。

### 【0092】

なお、イオン強度比が500以上のサンプルは、作製できなかった（試料159, 160, 169, 170, 179, 180, 189, 190, 199, 200）。また、試料番号152～158, 162～168, 172～178, 182～188, 192～198については、Rb拡散処理の前後において、バリスタ特性（電圧非直線性）は変化しないことが、別の実験により確認された。

### 【0093】

実施例5

$\text{Li}_2\text{CO}_3$  の代わりに、 $\text{Cs}_2\text{CO}_3$  を用いる以外は、実施例1と同様の条件で、素子を作製した。この結果を表5にまとめた。

【表 5】

試料番号	端子間 ギャップ $\mu\text{m}$	イオン強度比 (Cs/Zn)	半田リフロー後	
			絶縁抵抗値 $M\Omega$	不良率 %
*201	20	-(未処理)	0.02	100
*202		0.0001	0.05	100
*203		0.001	0.08	100
*204		0.01	0.06	100
*205		0.1	0.1	100
*206		1	0.13	100
*207		10	0.15	100
*208		100	0.13	100
*209		500	-	サンプル作製できず
*210		1000	-	サンプル作製できず
*211	50	-(未処理)	0.09	100
*212		0.0001	0.11	100
213		0.001	0.65	94
214		0.01	1.2	45
215		0.1	7.2	0
216		1	15	0
217		10	26	0
218		100	23	0
*219		500	-	サンプル作製できず
*220		1000	-	サンプル作製できず
*221	100	-(未処理)	0.11	100
*222		0.0001	0.12	100
223		0.001	0.88	68
224		0.01	1.4	30
225		0.1	8.6	0
226		1	19	0
227		10	30	0
228		100	28	0
*229		500	-	サンプル作製できず
*230		1000	-	サンプル作製できず
*231	300	-(未処理)	0.1	100
*232		0.0001	0.12	100
233		0.001	1.1	48
234		0.01	1.7	26
235		0.1	10	0
236		1	21	0
237		10	35	0
238		100	26	0
*239		500	-	サンプル作製できず
*240		1000	-	サンプル作製できず
*241	500	-(未処理)	0.12	100
*242		0.0001	0.13	100
243		0.001	1.5	34
244		0.01	2	16
245		0.1	13	0
246		1	21	0
247		10	31	0
248		100	22	0
*249		500	-	サンプル作製できず
*250		1000	-	サンプル作製できず

試料番号の\*は本発明の範囲外である。

**【0094】**

表5に示すように、Cs未処理の素子は、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が1MΩ未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%以上と高かった（試料201, 211, 221, 231, 241）。

**【0095】**

端子間ギャップが20μmの素子は、Cs処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が1MΩ未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料202～208）。絶縁不良率の改善に至らなかったのは、上記実施例1と同様の理由と考えられる。

**【0096】**

イオン強度比が0.0001以下の素子は、Cs処理していても、リフロー後における絶縁抵抗値の平均が1MΩ未満と低く、リフロー後の絶縁不良率も100%と高かった（試料212, 222, 232, 242）。

**【0097】**

端子間ギャップが50μm以上で、かつイオン強度比が0.001以上、1.0以下の素子は、試料213, 223を除き、絶縁抵抗値の平均が1.1MΩ以上で、1MΩ未満を示す素子はなく、しかも不良率は4.8%以下であった（試料214～218, 224～228, 233～238, 243～248）。特に、0.1以上1.0以下の素子は、絶縁抵抗値の平均が7.2MΩ以上で、より好ましいことが確認できた。

本実施例では、Cs拡散による高抵抗化の影響がバリスタ試料の電気特性に影響を与えないことが確認できた。これにより、高信頼性を確保できる。

**【0098】**

なお、イオン強度比が500以上のサンプルは、作製できなかった（試料209, 210, 219, 220, 229, 230, 239, 240, 249, 250）。また、試料番号202～208, 212～218, 222～228, 232～238, 242～248については、Cs拡散処理の前後において、バリスタ特性（電圧非直線性）は変化しないことが、別の実験により確認された。

**【0099】**

### 比較例 1

$\text{Li}_2\text{CO}_3$  を付着させて熱処理する工程を除いた以外は、実施例 1 と同様の条件で、端子間ギャップが  $500 \mu\text{m}$  の素子を作製した。

#### 【0100】

得られた素子は、リフロー前の絶縁抵抗が  $100\text{M}\Omega$  以上であったが、リフロー後は、 $0.1\text{M}\Omega$  になり、リフロー後の絶縁不良率は  $100\%$  であった。

#### 【0101】

##### 【発明の効果】

以上説明してきたように、本発明によれば、極小サイズ（たとえば、その寸法が縦  $0.6\text{mm}$  以下×横  $0.3\text{mm}$  以下×厚み  $0.3\text{mm}$  以下）のチップ状電子部品において、ガラスコートなどの絶縁保護層が不要であり、温度変化に強く、しかも半田リフローによっても素子表面の高抵抗を維持可能であり、高信頼性で、製造が容易な積層チップバリスタなどのチップ状電子部品およびその製造方法を提供することができる。

##### 【図面の簡単な説明】

【図 1】図 1 は本発明の一実施形態に係る積層チップバリスタの概略断面図である。

【図 2】図 2 は本発明の一実施形態に係る積層チップバリスタの製造工程を示すフローチャート図である。

【図 3】図 3 は本発明の他の実施形態に係る積層チップバリスタの製造工程を示すフローチャート図である。

##### 【符号の説明】

1 … 電圧非直線性抵抗体層

2 … 内部電極層

3 … 端子電極

4 … 高抵抗層

5 … 端子間ギャップ

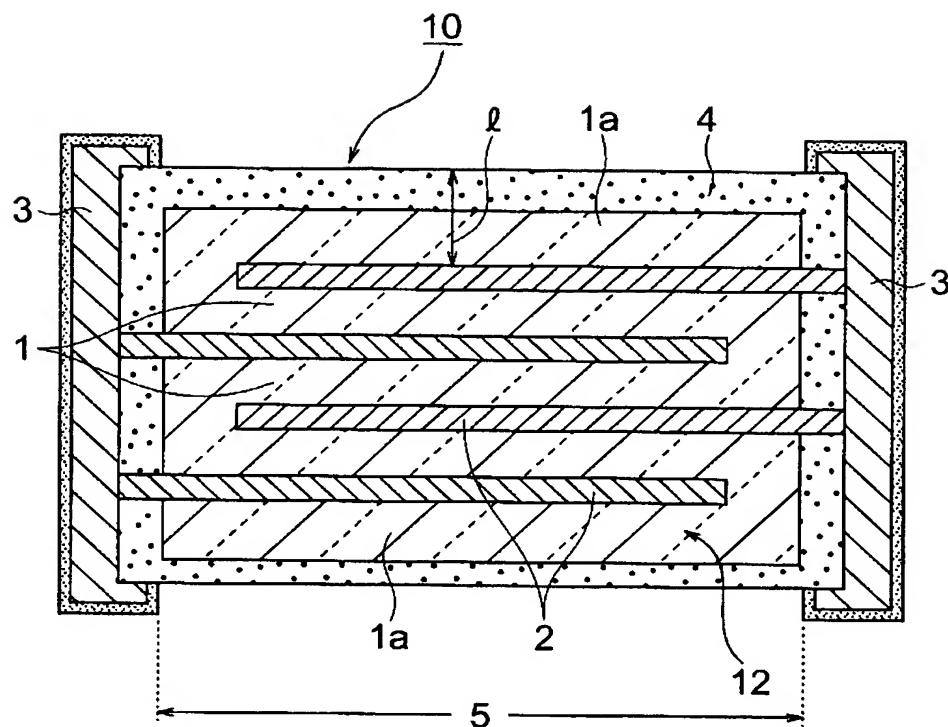
10 … 積層チップバリスタ

12 … 素子本体

【書類名】 図面

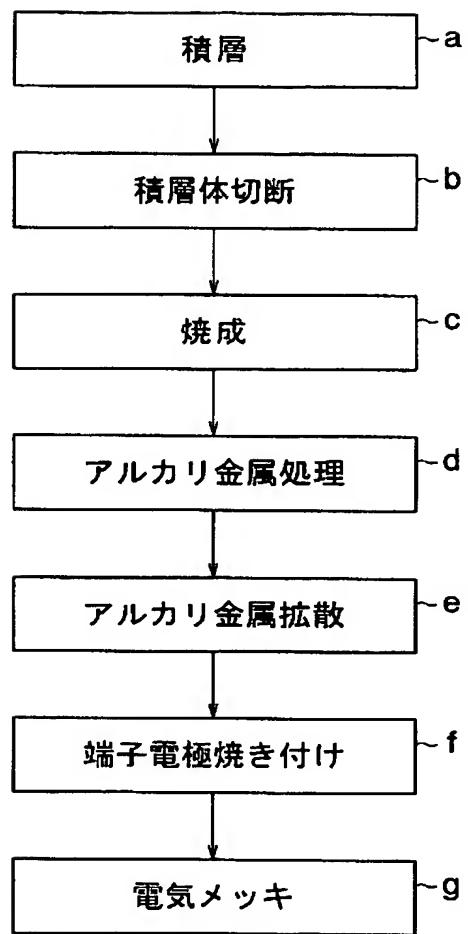
【図 1】

図 1

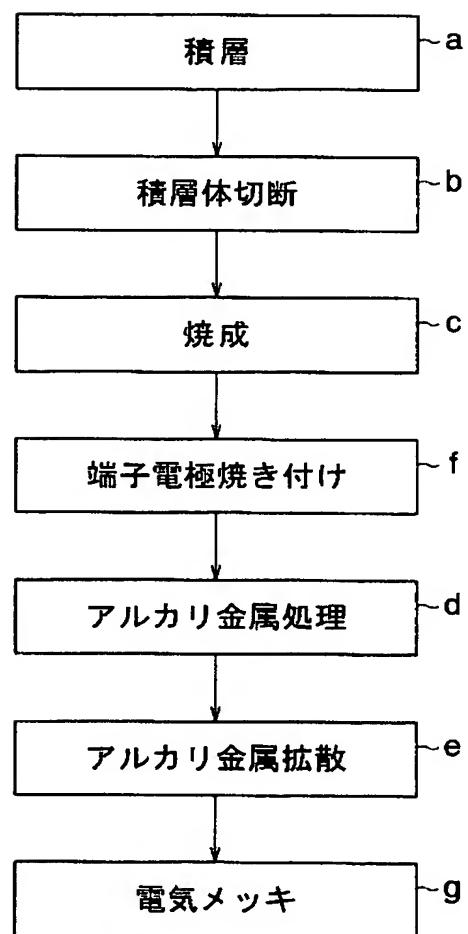


【図 2】

図 2



【図3】

図 3

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 極小サイズ（たとえば、その寸法が縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）のチップ状電子部品において、ガラスコートなどの絶縁保護層が不要であり、温度変化に強く、しかも半田リフローによっても素子表面の高抵抗を維持可能であり、高信頼性で、製造が容易な積層チップバリスタなどのチップ状電子部品およびその製造方法を提供すること。

【解決手段】 電圧非直線性抵抗体層1と内部電極層2とを有し、寸法が（縦0.6mm以下×横0.3mm以下×厚み0.3mm以下）の素子本体12と、該素子本体12の外面に形成され、同一平面上で対向する端部同士の距離（端子間ギャップ）が $50\mu m$ 以上の一对の端子電極3とを、持つ積層チップバリスタ10であって、前記内部電極層2の積層方向最外側から前記素子本体12の表面までの最短距離を1としたとき、前記素子本体12の表面から深さ（0.9×1）までの範囲を二次イオン質量分析法（SIMS）でLiとZnとのイオン強度比（Li/Zn）を測定した場合に、 $0.001 \leq (Li/Zn) \leq 500$ である。

【選択図】 図1

## 認定・付力口小青幸及

特許出願の番号	特願 2003-091476
受付番号	50300518567
書類名	特許願
担当官	末武 実 1912
作成日	平成 15 年 4 月 3 日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋 1 丁目 13 番 1 号

【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100097180

【住所又は居所】 東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル  
前田・西出国際特許事務所

【氏名又は名称】 前田 均

## 【代理人】

【識別番号】 100099900

【住所又は居所】 東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル  
前田・西出国際特許事務所

【氏名又は名称】 西出 真吾

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100111419

【住所又は居所】 東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル  
前田・西出国際特許事務所

【氏名又は名称】 大倉 宏一郎

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100117927

【住所又は居所】 東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル  
佐藤 美樹

次頁無

特願 2003-091476

出願人履歴情報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号  
氏 名 ティーディーケイ株式会社

2. 変更年月日 2003年 6月27日  
[変更理由] 名称変更  
住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号  
氏 名 TDK株式会社